
	<h2 style="color: red;">FDB8870-F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB8870-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB8870-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB8870-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB8870-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5200pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	132nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 23A (Ta), 160A (Tc) 160W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Ta), 160A (Tc)

FDB8870-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8870-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8870-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB8870-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB8860_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB8860_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB8860-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8870 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A TO-263AB</p>	 <p>FDB8870 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A TO-263AB</p>
 <p>FDB8874 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB</p>	 <p>FDB8876 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p>	 <p>FDB8874 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB</p>	 <p>FDB8876 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8870-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8870-F085 Datenblatt	FDB8870-F085-Datenblätter	FDB8870-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8870-F085
FDB8870-F085 Electronic	FDB8870-F085-Komponenten	FDB8870-F085-Verteiler	FDB8870-F085-Bild	FDB8870-F085-Teil
FDB8870-F085 Preis	FDB8870-F085 Hersteller	FDB8870-F085 Bild	FDB8870-F085 Aktie	FDB8870-F085 Inventar
FDB8870-F085 Neu	FDB8870-F085 Original	FDB8870-F085 garantiert	FDB8870-F085 RFQ	FDB8870-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited